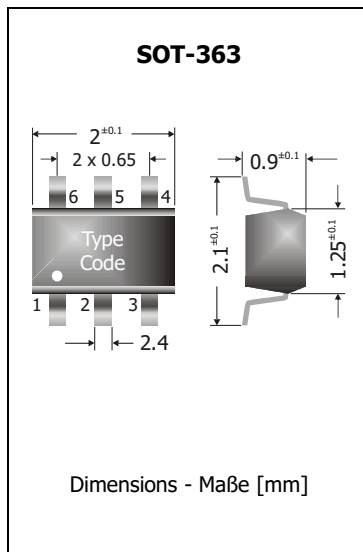


**BC672S**  
**SMD General Purpose NPN Transistors**  
**SMD Universal-NPN-Transistoren**

$I_C = 50 \text{ mA}$   
 $h_{FE} = 100 \dots 200$   
 $T_{jmax} = 150^\circ\text{C}$

$V_{CE0} = 18 \text{ V}$   
 $P_{tot} = 150 \text{ mW}$

Version 2020-07-10

**Typical Applications**

Signal processing,  
 Switching, Amplification  
 Commercial grade <sup>1)</sup>

**Features**

Two transistors in one package  
 General Purpose  
 Compliant to RoHS, REACH,  
 Conflict Minerals <sup>1)</sup>

**Mechanical Data <sup>1)</sup>**

Taped and reeled  
 Weight approx.  
 Case material  
 Solder & assembly conditions

3000 / 7"

0.01 g

UL 94V-0

260°C/10s

MSL = 1

**Typische Anwendungen**

Signalverarbeitung,  
 Schalten, Verstärken  
 Standardausführung <sup>1)</sup>

**Besonderheiten**

Zwei Transistoren in einem Gehäuse  
 Universell anwendbar  
 Konform zu RoHS, REACH,  
 Konfliktmineralien <sup>1)</sup>

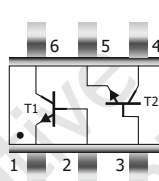
**Mechanische Daten <sup>1)</sup>**

Gegurtet auf Rolle

Gewicht ca.

Gehäusematerial

Löt- und Einbaubedingungen

Dual Transistors	<p>T1 1 = E1 2 = B1 6 = C1</p>  <p>T2 3 = B2 4 = C2 5 = E2</p>	<p>Type Code  <b>BC672S</b>          XN</p>
------------------	--	---

**Maximum ratings <sup>2)</sup>****Grenzwerte <sup>2)</sup>**

			<b>BC672S</b>
Collector-Emitter-voltage – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	$V_{CE0}$	18 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	E open	$V_{CBO}$	30 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	$V_{EBO}$	3 V
Power dissipation – Verlustleistung		$P_{tot}$	150 mW <sup>3)</sup>
Collector current – Kollektorstrom	DC	$I_C$	50 mA
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		$T_S$	-55...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_j$	-55...+150°C

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book

Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches

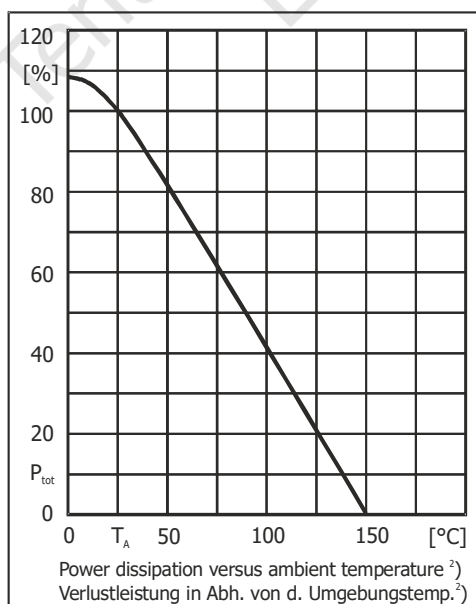
2  $T_A = 25^\circ\text{C}$  and per transistor, unless otherwise specified –  $T_A = 25^\circ\text{C}$  und pro Transistor, wenn nicht anders angegeben

3 Mounted on P.C. board with 3 mm<sup>2</sup> copper pad at each terminal

Montage auf Leiterplatte mit 3 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss

**Characteristics**
**Kennwerte**

$T_j = 25^{\circ}\text{C}$		Min.	Typ.	Max.	
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis					
$V_{CE} = 10\text{ V}$	$I_C = 10\text{ mA}$	$h_{FE}$	100	–	200
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Sättigungsspannung <sup>1)</sup>					
$I_C = 20\text{ mA}$	$I_B = 4\text{ mA}$	$V_{CEsat}$	–	–	500 mV
Collector-Base breakdown voltage – Kollektor-Basis Durchbruchspannung <sup>1)</sup>					
$I_C = 10\text{ }\mu\text{A}$ , E open		$V_{(BR)CBO}$	30 V	–	–
Collector-Emitter breakdown voltage – Kollektor-Emitter Durchbruchspannung <sup>1)</sup>					
$I_C = 1\text{ mA}$ , B open		$V_{(BR)CEO}$	18 V	–	–
Base-Emitter breakdown voltage – Basis-Emitter Durchbruchspannung <sup>1)</sup>					
$I_E = 10\text{ }\mu\text{A}$ , C open		$V_{(BR)BEO}$	3 V	–	–
Collector-Base cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom					
$V_{CB} = 10\text{ V}$	E open	$I_{CBO}$	–	–	500 nA
Emitter-Base cutoff current – Emitter-Basis-Reststrom					
$V_{EB} = 2\text{ V}$	C open	$I_{EBO}$	–	–	500 nA
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz					
$V_{CE} = 10\text{ V}$ , $I_C = 10\text{ mA}$ , $f = 200\text{ MHz}$		$f_T$	600 MHz	–	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität					
$V_{CB} = 10\text{ V}$ , $I_E = i_e = 0$ , $f = 1\text{ MHz}$		$C_{CBO}$	–	–	1.6 pF
Typical thermal resistance junction to ambient (per device) Typischer Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung (pro Bauteil)		$R_{thA}$	420 K/W <sup>2)</sup>		



**Disclaimer:** See data book page 2 or [website](#)  
**Haftungsschluss:** Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

- 1 Tested with pulses  $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$  – Gemessen mit Impulsen  $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$ , Schaltverhältnis  $\leq 2\%$
- 2 Mounted on P.C. board with  $3\text{ mm}^2$  copper pad at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit  $3\text{ mm}^2$  Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss